Laboratorium podstaw elektroniki SK2A – Ćw. 12 Wzmacniacze małej częstotliwości w układzie wspólnego emitera									
Rodzaj studiów:	OKNO PW		Termin Zjazdu	19-23.06.2023					
Zjazd	3	Data i godzina:	21.06 2023 r	Nr zespołu:	BX				
Skład zespołu:	Piore	PIOTE HEINTEUMAN 6 M.							

## 1a. Obliczenie wzmocnienia napięciowego wzmacniacza małej częstotliwości

Wzmocnienie napięciowe obliczono ze wzoru:

$$k_{U} = \frac{3.92}{0.77} = \frac{3.92}{0.77} = 3.92 \text{ V/V}$$

## 1b. Wyznaczanie charakterystyki amplitudowej wzmacniacza małej częstotliwości

Wzmocnienie napięciowe w granicy pasma przenoszenia:

$$k_{U_8} = 4.33$$
  $V_N = \frac{V_2}{V_1} = \frac{4.33}{1.2V} = 4.33 V_V$ 

Uzyskane częstotliwości charakterystyczne pasma przenoszenia:

$$f_{d1} = \frac{10}{\text{Hz}}$$

$$f_{d2} = \frac{211}{\text{Hz}}$$

$$f_{g1} = \frac{1200}{\text{Hz}}$$

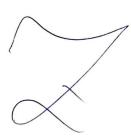
$$f_{g2} = \frac{4000}{\text{kHz}}$$

$$Hz$$

Aproksymowana charakterystyka amplitudowa wzmacniacza:

## 2a-b. Oszacowanie wartości rezystancji w układzie bezpośredniego zasilania bez sprzężenia zwrotnego.

Schemat analizowanego układu:



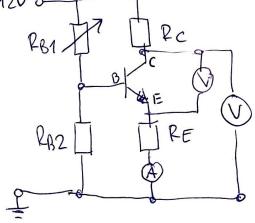
Obliczenia:

Laboratorium podstaw elektroniki SK2A – Ćw. 11 Tranzystory bipolarne – obszar pracy aktywnej tranzystora									
Rodzaj studiów:	OKNO PW		Termin Zjazdu	19-23.06.2023					
Zjazd	3	Data i godzina:	21.06.20232	Nr zespołu:	BX				
Skład zespołu:	RITOTAL Adam PIOTE PLEINZEUNIN								

MERWONL

1a-b. Oszacowanie wartości rezystancji w układzie bezpośredniego zasilania ze sprzężeniem 12V 0 emiterowym.

Schemat analizowanego układu:



Obliczenia:

$$Icq = 2mA$$

$$R_{C} + R_{E} = \frac{|O_{1} - O_{1}| R_{C}}{|C_{Q}|} = \frac{6V}{2mA} = 3k \sqrt{\frac{|R_{B1}|}{|R_{B2}|}} = \frac{50 \cdot 16 \mu A}{1684} = \frac{8c}{2mA}$$

$$R_{C} + R_{E} = \frac{|U_{C}|}{|C_{Q}|} = \frac{6V}{2mA} = 3k \sqrt{\frac{|R_{B1}|}{|R_{B2}|}} = \frac{500 \mu A}{1684} = \frac{8c}{2mA}$$

$$\frac{100}{100} = \frac{2mA}{120} = 16\mu A \quad 12 Rc = 3kD$$

$$Rc = \frac{3kD}{120} = 2.5kD$$

Uzyskane wyniki:

$$R_{c} = 2.5 \text{ KD}_{R_{E}} = 0.5 \text{ KD}_{L}, R_{B1} = 12.87 \text{ KD}_{L}, R_{B2} = 2.125 \text{ KD}_{L}$$

## 1c. Ustawienie punktu pracy tranzystora, tak aby wzmacniacz jednotranzystorowy pracował w klasie A

Rzeczywisty punkt pracy tranzystora:

$$U_{CEQ} = \underbrace{5.97}_{CQ} \qquad V$$

$$I_{CQ} = \underbrace{1.95}_{MR} \qquad mA$$

$$U_{BEQ} = \underbrace{5.8}_{MR} \qquad mV$$

2a. Wnioski.

Pry tak dobranych elementach transystor pracifie wedicy wylicen teoretyrny i pracije on jako iszmacnian i Iclasie 4.

